

日程表(分科別1)

大分類分科名 中分類分科名 SP 特別企画	2019年9月18日(水)		2019年9月19日(木)		2019年9月20日(金)		2019年9月21日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
SP1 秋季講演会第80回記念シンポジウム「北緯43°からの独創研究発信—はやぶさ宇宙科学、雪と氷の科学、粘菌数理論科学、新光触媒科学—」						E101 13:30 ~ 16:55		
NT シンポジウム (non-technical)								
NT1 応用物理と感性						E308 13:30 ~ 17:20		
T シンポジウム (technical)								
T1 システム指向の自然エネルギー利用技術				E216 13:30 ~ 18:15				
T2 科学教育の人材育成および教育の取り組みとその活性化 —北海道地区—							E311 13:00 ~ 15:50	
T3 量子ビーム利用の最前線 ~医療・産業利用の現状と将来~				N304 13:45 ~ 16:30				
T4 フォトニクスが生み出すイノベーションと新産業創出Ⅱ ~羽ばたく大学発ベンチャー! バイオ・メディカルを中心に~				E208 13:30 ~ 16:55				
T5 光が拓く量子技術の新展開				E301 14:00 ~ 16:45				
T6 パワーエレクトロニクスと薄膜・表面技術~省エネルギー社会に向けて~				B01 13:30 ~ 16:45				
T7 薄膜表面・界面評価法の新展開			B31 09:00 ~ 11:45	B31 13:15 ~ 17:15				
T8 センシング・情報処理・応答の異機能が統合するトータルバイオミメティック物質科学						B01 13:30 ~ 17:50		
T9 強誘電体材料の将来デバイスへの応用						C309 13:45 ~ 18:00		
T10 酸化物中の水素とその役割						C212 14:00 ~ 18:00		
T11 プラズマ制御「前駆体」が拓く生命科学と材料科学				B32 13:30 ~ 17:15				
T12 複合アニオン化合物を用いた新機能性材料開発				C310 13:30 ~ 16:35				
T13 宇宙実験と磁場中実験で拓く重力制御科学				E201 13:30 ~ 17:30				
T14 新しいスピントロニクス材料と物性				N302 13:30 ~ 17:45				
T15 有機薄膜太陽電池研究のもう一つの道 (屋内光向けおよびその標準化、光透過型)						E307 13:30 ~ 17:00		
T16 固体表面とバイオ表面の共生:サイバー空間と生体の対話へむけて						B32 13:30 ~ 17:15		
T17 先端的光学テクノロジーで拓ける有機エレクトロニクス								
T18 脱炭素社会実現に向けた太陽光発電のポテンシャルと挑戦 ~電力を越えて、移動体、建物、さらにその先へ~	E301 10:30 ~ 12:15	E301 13:45 ~ 17:30						
T19 界面ナノ電子化学「多様化する半導体ウェットプロセス」				B11 13:30 ~ 17:00				
T20 先端イオン顕微鏡技術って何? ナノスケール材料・デバイスへの展開				E302 13:30 ~ 17:30				
T21 アトミックレイヤープロセスの最新動向						N304 13:30 ~ 17:45		
T22 窒化物半導体エッチング技術 ~高制御性と低損傷性を求めて~						E301 13:30 ~ 17:35		
T23 窒化物半導体特異構造の科学 ~新機能性の発現と電子・光デバイスへの展開~		E101 13:30 ~ 17:30						
T24 結晶シリコン太陽電池の現在地と未来				B12 13:15 ~ 18:30				
T25 ナノカーボン・原子層物質の新展開と将来展望						E201 13:30 ~ 18:15		
T26 インフォマティクスが創る新しい材料科学とその実用化	B01 10:00 ~ 12:25	B01 13:45 ~ 18:05						
T27 数理がひもどく自然・生命現象と知的計算能力							F211 09:00 ~ 12:50	
TU チュートリアル								
TU1 イチから始めるAI実験 (渡辺 英治)						N302 14:30~17:00		
TU2 半導体デバイス: その動作原理を物理の基礎から理解する! — もう一度、学部基礎から復習してみよう — (柴田 直)	N302 9:00~11:30							
TU3 X線光電子分光法のこれまでとこれから (高桑 雄二)		E318 13:30~16:30						
TU4 高温超伝導材料の合成と結晶成長 (下山 淳一)		E319 13:30~16:00						
TU5 有機半導体の基礎と応用 (竹谷 純一)	E319 9:00~11:30							
CS コードシェアセッション								
CS1 3.3 情報フォトニクス・画像工学と4.4 Information Photonicsのコードシェアセッション	E215 10:30 ~ 11:45	E215 13:15 ~ 16:15	E215 10:15 ~ 11:45					
CS2 3.5 レーザー装置・材料と3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション						E203 13:45 ~ 15:15		
CS3 3.10 光量子物理・技術、3.11 フォトニック構造・現象、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート、11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用、13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコードシェアセッション			E208 09:00 ~ 12:15		N304 09:00 ~ 11:45			
CS4 3.11 フォトニック構造・現象と3.12 ナノ領域光学・近接場光学のコードシェアセッション							E208 09:00 ~ 12:15	
CS5 3.11 フォトニック構造・現象と3.13 半導体光デバイスのコードシェアセッション					E207 09:00 ~ 12:00			
CS6 6.5 表面物理・真空と7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション						E319 13:45 ~ 16:30		
CS7 7.2 電子ビーム応用、7.4 量子ビーム界面構造計測、9.5 新機能材料・新物性のコードシェアセッション	E318 09:00 ~ 12:45		E318 09:00 ~ 12:15		E318 09:00 ~ 12:00	E318 13:00 ~ 16:45		
CS8 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)、10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術、10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術、10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関のコードシェアセッション					E216 10:45 ~ 12:30	E216 13:30 ~ 15:15		

日程表(分科別2)

大分類分科名 中分類分科名	2019年9月18日(水)		2019年9月19日(木)		2019年9月20日(金)		2019年9月21日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
31 フォークセッション「AIエレクトロニクス」								
31.1 フォークセッション「AIエレクトロニクス」				PB6 13:30 ~ 15:30 F211 15:45 ~ 18:15	F211 09:30 ~ 12:15	F211 13:45 ~ 17:45		
1 応用物理学一般								
1.1 応用物理一般・学際領域	PA1 09:30 ~ 11:30	C206 13:15 ~ 15:15						
1.2 教育							PA1 09:30 ~ 11:30	
1.3 新技術・複合新領域	PA2 09:30 ~ 11:30		C206 09:30 ~ 11:45					
1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境		E313 13:30 ~ 15:45	PA1 09:30 ~ 11:30					
1.5 計測技術・計測標準	PA3 09:30 ~ 11:30					E313 13:15 ~ 17:45		
1.6 超音波	C206 09:00 ~ 12:15	PA3 16:00 ~ 18:00						
2 放射線								
2.1 放射線物理一般・検出器基礎						PB4 16:00 ~ 18:00	C213 09:00 ~ 11:45	C213 13:00 ~ 14:45
2.2 検出器開発		C213 13:15 ~ 17:30	C213 10:00 ~ 11:45	N304 13:30 ~ 13:45				
2.3 放射線応用・発生装置・新技術					E305 09:15 ~ 12:00	E305 13:45 ~ 15:30		
2.4 加速器質量分析・加速器ビーム分析		E312 13:30 ~ 15:30				PB4 16:00 ~ 18:00	E303 09:00 ~ 12:30	
3 光・フォトニクス								
3.1 光学基礎・光学新領域	E204 09:00 ~ 12:00	E204 13:45 ~ 18:00	E204 09:00 ~ 12:00	PA1 13:30 ~ 15:30				
3.2 材料・機器光学	E205 09:00 ~ 11:30	PA1 13:30 ~ 15:30	E207 09:00 ~ 11:15					
3.3 情報フォトニクス・画像工学				E319 13:15 ~ 19:00	PA1 09:30 ~ 11:30			
CS1 3.3 情報フォトニクス・画像工学と4.4 Information Photonicsの コードシェアセッション	E215 10:30 ~ 11:45	E215 13:15 ~ 16:15	E215 10:15 ~ 11:45					
3.4 生体・医用光学					E313 09:00 ~ 11:45	PA1 13:30 ~ 15:30	E206 09:00 ~ 11:45	E206 13:15 ~ 16:00
3.5 レーザー装置・材料					PA2 09:30 ~ 11:30	E203 15:30 ~ 19:00	E203 09:00 ~ 11:30	E203 13:00 ~ 14:15
CS2 3.5 レーザー装置・材料と3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコード シェアセッション						E203 13:45 ~ 15:15		
3.6 超高速・高強度レーザー	PA4 09:30 ~ 11:30	E205 13:15 ~ 18:00	E205 09:00 ~ 12:15	E205 13:45 ~ 19:00				
3.7 レーザープロセス	N304 09:30 ~ 11:45	N304 13:15 ~ 17:30	N304 09:00 ~ 11:45	PA2 13:30 ~ 15:30				
3.8 光計測技術・機器					E303 15:45 ~ 18:00			
3.9 テラヘルツ全般		E206 14:00 ~ 17:30	PA2 09:30 ~ 11:30			E205 09:00 ~ 12:15	E205 13:45 ~ 17:00	E205 09:00 ~ 12:15
3.10 量子物理・技術						E206 09:00 ~ 12:15	PA5 16:00 ~ 18:00	E207 09:00 ~ 11:45
CS3 3.10 量子物理・技術、3.11 フォトニック構造・現象、9.2 ナノ粒 子・ナノワイヤ・ナノシート、11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応 用、13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコードシェアセッション			E208 09:00 ~ 12:15		N304 09:00 ~ 11:45			E207 13:15 ~ 16:00
3.11 フォトニック構造・現象				E207 13:15 ~ 15:45 PA5 16:00 ~ 18:00		E207 13:45 ~ 18:00		E205 13:15 ~ 16:00
CS3 3.10 量子物理・技術、3.11 フォトニック構造・現象、9.2 ナノ粒 子・ナノワイヤ・ナノシート、11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応 用、13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコードシェアセッション			E208 09:00 ~ 12:15		N304 09:00 ~ 11:45			
CS4 3.11 フォトニック構造・現象と3.12 ナノ領域光科学・近接場光学の コードシェアセッション							E208 09:00 ~ 12:15	
CS5 3.11 フォトニック構造・現象と3.13 半導体光デバイスのコードシェア セッション						E207 09:00 ~ 12:00		
3.12 ナノ領域光科学・近接場光学				E314 13:00 ~ 16:00 PA6 16:00 ~ 18:00	E208 09:00 ~ 12:00	E208 13:15 ~ 19:00		E208 13:30 ~ 16:00
CS4 3.11 フォトニック構造・現象と3.12 ナノ領域光科学・近接場光学の コードシェアセッション							E208 09:00 ~ 12:15	
3.13 半導体光デバイス		PA3 09:30 ~ 11:30	E204 13:45 ~ 17:15		E204 09:00 ~ 11:15	E204 13:45 ~ 17:00		
CS5 3.11 フォトニック構造・現象と3.13 半導体光デバイスのコードシェア セッション					E207 09:00 ~ 12:00			
3.14 光制御デバイス・光ファイバー						PA6 16:00 ~ 18:00	E204 09:00 ~ 11:15	E204 13:45 ~ 15:15
CS2 3.5 レーザー装置・材料と3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコード シェアセッション						E203 13:45 ~ 15:15		
3.15 シリコンフォトニクス	PA5 09:30 ~ 11:30		E206 09:00 ~ 11:45	E206 13:15 ~ 18:45				

日程表(分科別3)

大分類分科名 中分類分科名	2019年9月18日(水)		2019年9月19日(木)		2019年9月20日(金)		2019年9月21日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
4 JSAP-OSA Joint Symposia 2019								
4.1 Plasmonics and Nanophotonics	E208 09:00 ~ 11:30	E208 13:15 ~ 18:00			PA3 09:30 ~ 11:30	E215 14:30 ~ 16:15		
4.2 Photonics Devices, Photonic Integrated Circuit and Silicon Photonics					E215 10:00 ~ 11:45			
4.3 Ultrafast Optics and Laser Processing					E214 09:00 ~ 11:45	E214 13:15 ~ 18:30		
4.4 Information Photonics ※CS1 3.3 情報フォトンクス・画像工学とのコードシェアセッションとして開催	E215 10:30 ~ 11:45	E215 13:15 ~ 16:15	E215 10:15 ~ 11:45					
4.5 Terahertz Photonics				E215 12:45 ~ 18:30	PA3 09:30 ~ 11:30			
4.6 Quantum Optics and Nonlinear Optics					PA3 09:30 ~ 11:30		E214 09:00 ~ 11:45	E214 13:15 ~ 14:45
6 薄膜・表面								
6.1 強誘電体薄膜				PA3 13:30 ~ 15:30	C309 09:00 ~ 12:30		C309 09:00 ~ 12:30	C309 13:45 ~ 16:00
6.2 カーボン系薄膜		PA4 16:00 ~ 18:00	E312 09:30 ~ 12:00	E312 13:30 ~ 17:15	E312 09:15 ~ 12:00	E312 13:30 ~ 17:30		
6.3 酸化物エレクトロニクス	E311 09:00 ~ 11:30	E311 13:15 ~ 18:00	E311 09:30 ~ 11:45	E311 13:15 ~ 17:00			PA2 09:30 ~ 11:30	N302 13:15 ~ 16:00
6.4 薄膜新材料		PA5 16:00 ~ 18:00			C310 09:00 ~ 12:15	C310 13:45 ~ 18:00	C310 09:00 ~ 12:15	C310 13:45 ~ 14:45
6.5 表面物理・真空					E319 10:00 ~ 11:45	PB1 13:30 ~ 15:30	E319 09:00 ~ 10:15	
CS6 6.5 表面物理・真空と7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション						E319 13:45 ~ 16:30		
6.6 プローブ顕微鏡	C310 09:30 ~ 12:15	C310 13:30 ~ 17:15	C310 09:00 ~ 12:15	PA4 13:30 ~ 15:30				
7 ビーム応用								
7.1 X線技術				E318 13:30 ~ 16:30		PB2 13:30 ~ 15:30		
7.2 電子ビーム応用						PB2 13:30 ~ 15:30		
CS7 7.2 電子ビーム応用、7.4 量子ビーム界面構造計測、9.5 新機能材料・新物性のコードシェアセッション	E318 09:00 ~ 12:45		E318 09:00 ~ 12:15		E318 09:00 ~ 12:00	E318 13:00 ~ 16:45		
7.3 微細パターン・微細構造形成技術					E307 10:00 ~ 11:45	PB2 13:30 ~ 15:30		
7.4 量子ビーム界面構造計測						PB2 13:30 ~ 15:30		
CS7 7.2 電子ビーム応用、7.4 量子ビーム界面構造計測、9.5 新機能材料・新物性のコードシェアセッション	E318 09:00 ~ 12:45		E318 09:00 ~ 12:15		E318 09:00 ~ 12:00	E318 13:00 ~ 16:45		
7.5 イオンビーム一般					E203 09:00 ~ 12:15	PB2 13:30 ~ 15:30		
7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術 ※CS6 6.5 表面物理・真空とのコードシェアセッションとして開催						E319 13:45 ~ 16:30		
8 プラズマエレクトロニクス								
8.1 プラズマ生成・診断	PA6 09:30 ~ 11:30				B11 09:00 ~ 11:45	B11 13:15 ~ 17:15		
8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理	C309 09:00 ~ 12:00	C309 13:45 ~ 17:15			PA4 09:30 ~ 11:30			
8.3 プラズマナノテクノロジー	F211 09:45 ~ 12:00				PA5 09:30 ~ 11:30			
8.4 プラズマライフサイエンス					PA6 09:30 ~ 11:30	E306 13:15 ~ 17:00		
8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野	PA7 09:30 ~ 11:30				E306 09:00 ~ 12:15			
8.6 Plasma Electronics English Session		F211 13:45 ~ 16:00			PA7 09:30 ~ 11:30			
8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演			B32 10:30 ~ 11:00					
8.8 プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演			B32 09:30 ~ 10:30					
9 応用物性								
9.1 誘電材料・誘電体	E317 09:00 ~ 11:45	E317 13:15 ~ 16:30	PB1 09:30 ~ 11:30					
9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	PB1 09:30 ~ 11:30		E317 09:00 ~ 11:45	E317 13:15 ~ 18:45	E317 09:00 ~ 11:30			
CS3 3.10 光量子物理・技術、3.11 フォトニック構造・現象、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート、11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用、13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコードシェアセッション			E208 09:00 ~ 12:15		N304 09:00 ~ 11:45			
9.3 ナノエレクトロニクス	PB2 09:30 ~ 11:30					E317 13:30 ~ 16:00		
9.4 熱電変換			E307 09:00 ~ 11:45	E307 13:15 ~ 17:30	PB1 09:30 ~ 11:30			
9.5 新機能材料・新物性		PA6 16:00 ~ 18:00						
10 スピントロニクス・マグネティクス								
CS8 10.1 新物質・新機能創成（作製・評価技術）、10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術、10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術、10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関のコードシェアセッション					E216 10:45 ~ 12:30	E216 13:30 ~ 15:15		
10.1 新物質・新機能創成（作製・評価技術）		PB1 13:30 ~ 15:30	E216 09:00 ~ 12:15		E216 09:00 ~ 10:30			
10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術		E216 16:15 ~ 18:00						
10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術		PB1 13:30 ~ 15:30				E216 15:30 ~ 19:00	E216 09:00 ~ 10:00	
10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関	E216 09:00 ~ 12:15	E216 13:15 ~ 16:00					E216 10:15 ~ 12:15	E216 13:15 ~ 14:45
10.5 磁場応用		PB1 13:30 ~ 15:30	E201 09:00 ~ 11:45					

日程表(分科別4)

大分類分科名 中分類分科名	2019年9月18日(水)		2019年9月19日(木)		2019年9月20日(金)		2019年9月21日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
11 超伝導								
11.1 基礎物性			PB2 09:30 ~ 11:30	C213 13:30 ~ 18:30	C213 09:30 ~ 11:00			
11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長						C207 13:15 ~ 17:45		
11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用					C206 13:15 ~ 16:00			
11.4 アナログ応用および関連技術					C207 13:15 ~ 18:00	C207 09:00 ~ 10:45		
11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用							C213 13:15 ~ 17:00	
CS3 3.10 量子物理・技術, 3.11 フォトニック構造・現象, 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート, 11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用, 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコードシェアセッション			E208 09:00 ~ 12:15		N304 09:00 ~ 11:45			
12 有機分子・バイオエレクトロニクス								
12.1 作製・構造制御				PB7 16:00 ~ 18:00	E202 09:00 ~ 11:45	E202 13:45 ~ 18:45		
12.2 評価・基礎物性	E302 09:00 ~ 12:15	E302 13:45 ~ 18:15	E302 09:00 ~ 11:45		E308 09:00 ~ 11:45	PA2 13:30 ~ 15:30		
12.3 機能材料・萌芽的デバイス	B12 09:00 ~ 11:45	B12 13:15 ~ 18:00	B12 09:00 ~ 12:00		E101 09:00 ~ 11:45	PA3 13:30 ~ 15:30		
12.4 有機EL・トランジスタ		E310 13:45 ~ 18:15	C212 09:00 ~ 11:45	E306 13:15 ~ 15:00			B32 09:00 ~ 11:30	B32 13:00 ~ 16:30
12.5 有機太陽電池	E101 09:00 ~ 12:15		E101 09:00 ~ 12:15	E101 13:45 ~ 18:00	PB2 09:30 ~ 11:30		E101 09:00 ~ 12:15	E101 13:45 ~ 15:15
12.6 ナノバイオテクノロジー	E203 09:00 ~ 12:15	E203 13:45 ~ 18:00	E203 09:00 ~ 12:15	E203 13:45 ~ 16:00				
12.7 医用工学・バイオチップ	E202 09:00 ~ 12:00	E202 13:00 ~ 18:00	E202 09:00 ~ 12:15	PB1 13:30 ~ 15:30 E202 16:00 ~ 18:45				
13 半導体								
13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	E303 09:00 ~ 12:15	E303 13:45 ~ 16:45			PB3 09:30 ~ 11:30			
13.2 探索的材料物性・基礎物性					E303 10:30 ~ 11:45	E303 13:45 ~ 17:45	PA3 09:30 ~ 11:30	
13.3 絶縁膜技術		PB2 16:00 ~ 18:00	E305 09:00 ~ 12:15	E305 13:45 ~ 17:45				
13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	E304 09:30 ~ 11:45	E304 13:45 ~ 16:15	E304 09:00 ~ 12:00	E304 13:45 ~ 17:15		PA7 16:00 ~ 18:00		
13.5 デバイス/配線/集積化技術	B11 09:00 ~ 12:00	B11 13:15 ~ 17:00	B11 09:00 ~ 11:30	PB2 13:30 ~ 15:30				
13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス				C309 13:45 ~ 18:30		PB3 13:30 ~ 15:30		
CS3 3.10 量子物理・技術, 3.11 フォトニック構造・現象, 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート, 11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用, 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコードシェアセッション			E208 09:00 ~ 12:15		N304 09:00 ~ 11:45			
13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術		N302 13:00 ~ 18:00	E301 09:00 ~ 12:00	PB3 13:30 ~ 15:30	E301 09:00 ~ 12:15		E301 09:00 ~ 12:30	E301 13:45 ~ 15:30
13.8 光物性・発光デバイス			PB3 09:30 ~ 11:30		E302 09:00 ~ 12:15	E302 13:45 ~ 18:15	E302 09:00 ~ 12:15	
13.9 化合物太陽電池			E315 09:15 ~ 12:15	E315 13:45 ~ 15:30	E315 09:30 ~ 11:45	B12 13:15 ~ 16:15		
				PB10 16:00 ~ 18:00				
15 結晶工学								
15.1 バルク結晶成長	E207 09:00 ~ 11:45	E207 13:15 ~ 17:15	PB4 09:30 ~ 11:30					
15.2 II-VI族結晶および多元系結晶	E206 09:00 ~ 10:30	PB3 16:00 ~ 18:00						
15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	B31 09:00 ~ 11:30	B31 13:15 ~ 18:00	PB5 09:30 ~ 11:30					
15.4 III-V族窒化物結晶	E310 09:00 ~ 11:45 PB3 09:30 ~ 11:30		E310 09:00 ~ 11:45	E310 13:15 ~ 19:00	E310 09:00 ~ 11:45	E310 13:15 ~ 19:00	E310 09:00 ~ 11:45	E310 12:45 ~ 16:00
15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶		PA2 13:30 ~ 15:30	E313 09:30 ~ 12:00	E313 13:30 ~ 15:45				
15.6 IV族系化合物 (SiC)				PB4 13:30 ~ 15:30	E311 09:00 ~ 12:00	E311 13:30 ~ 18:15	E311 09:00 ~ 10:45	
15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	C212 09:00 ~ 12:00	C212 13:30 ~ 15:00 PB4 16:00 ~ 18:00						
16 非晶質・微結晶								
16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス				PA7 16:00 ~ 18:00	E304 09:00 ~ 11:45	E304 13:45 ~ 17:15		
16.2 エナジーハーベスティング			E303 09:00 ~ 10:30					
16.3 シリコン系太陽電池			PA4 09:30 ~ 11:30		E314 09:15 ~ 11:30	E314 13:30 ~ 17:15	B12 09:15 ~ 11:30	B12 13:30 ~ 14:45
17 ナノカーボン								
17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料	E307 09:45 ~ 11:45	E307 13:15 ~ 17:15						
17.2 グラフェン	E308 09:00 ~ 11:30	E308 13:15 ~ 18:00		E308 16:45 ~ 17:45			PB1 09:30 ~ 11:30	
17.3 層状物質			E308 09:30 ~ 11:45	E308 13:15 ~ 16:45	E201 09:00 ~ 11:45			E201 12:30 ~ 14:30
21 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」								
21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」		PB5 16:00 ~ 18:00			B31 09:00 ~ 12:15	B31 13:45 ~ 18:30	B31 09:00 ~ 11:15	B31 12:45 ~ 16:30
22 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」								
22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	E214 10:00 ~ 11:45	E214 13:15 ~ 17:00	E214 10:00 ~ 11:15	E214 13:15 ~ 16:45	PB4 09:30 ~ 11:30			
23 合同セッションN「インフォマティクス応用」								
23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」			B01 09:00 ~ 11:45	PB5 13:30 ~ 15:30	B01 09:00 ~ 11:45		B01 09:00 ~ 11:45	